

RC1100



北海道大学蔵納設備

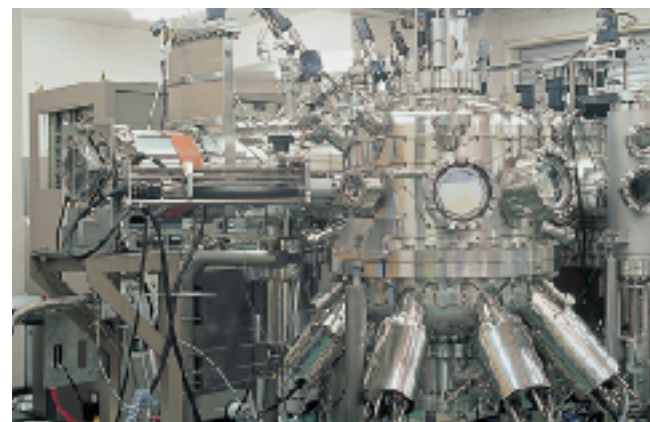
特徴

低価格、省スペースしかも高性能を実現した小型研究用MBE装置です。小型機ながら本格的な研究が可能です。STMなどの分析装置と組み合わせて、新しい材料開発をサポートします。

仕様

- 基板サイズ：φ1×1
- Kセルポート：ICF114×6

RC2100/RC3100



上智大学蔵納設備

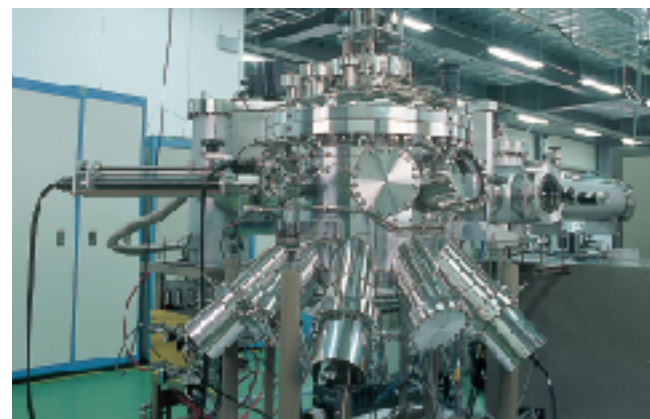
特徴

より高度な研究から、準生産用に最適なMBE装置です。窒化物半導体をはじめZnOなどの材料開発をサポートします。

仕様

- 基板サイズ：φ2×1 (RC2100)
φ3×1 (RC3100)
- Kセルポート：ICF114×8 (RC2100)
ICF152×8 (RC3100)

RC6100



産業技術総合研究所蔵納設備

特徴

独自の分子線シミュレーション技術により、設計されたセル基板配置により、大面積基板上に均一に高い結晶成長が行えます。

仕様

- 基板サイズ：φ6×1
- Kセルポート：ICF152×10

MBE装置主要性能

型式	RC1100	RC2100/RC3100	RC6100
到達圧力 (Pa)	$<1.33 \times 10^{-8}$	$<1.33 \times 10^{-8}$	$<1.33 \times 10^{-8}$
基板 (ウエハ) サイズ×枚数	φ1×1	φ2×1 / φ3×1	φ6×1
基板加熱温度 (標準仕様)	900°C	900°C	900°C
(制御用熱電対値) (オプション仕様)	1200°C	1200°C	1200°C
分子線セルポート (サイズ×数)	ICF114×6	ICF114×8 / ICF152×8	ICF152×10
伸縮式フラックスモニター	標準装備	標準装備	標準装備
イオンポンプ	270l/sec	500l/sec	500l/sec
ターボ分子ポンプ	オプション	オプション	オプション
クライオポンプ	—	オプション	オプション
RHEEDシステム (30KeV)	標準装備	標準装備	標準装備
RHEEDスクリーンサイズ	ICF152	ICF152 / ICF203	ICF203
到達圧力 (Pa)	$<1.33 \times 10^{-7}$	$<1.33 \times 10^{-7}$	$<1.33 \times 10^{-7}$
コンピネーションポンプ	150l/sec	150l/sec	150l/sec
搬送機構	トランスファーロード式	トランスファーロード式	トランスファーロード式
レール搬送機構	オプション	オプション	オプション
到達圧力 (Pa)	$<1.33 \times 10^{-7}$	$<1.33 \times 10^{-7}$	$<1.33 \times 10^{-7}$
コンピネーションポンプ	300l/sec	300l/sec	300l/sec
搬送機構	回転伸縮アーム式	回転伸縮アーム式	回転伸縮アーム式
拡張ポート (サイズ×数)	ICF152×2	ICF152×2	ICF203×2
到達圧力 (Pa)	$<1.33 \times 10^{-5}$	$<1.33 \times 10^{-5}$	$<1.33 \times 10^{-5}$
ターボ分子ポンプ	300l/sec	300l/sec	300l/sec
予備加熱機構 (Max500°C)	標準装備	標準装備	標準装備
基板保管機構 (4段階)	標準装備	標準装備	標準装備
搬送機構 (回転伸縮の場合不要)	トランスファーロード式またはレール式	トランスファーロード式またはレール式	トランスファーロード式またはレール式
操作パネル (タッチパネル)	標準装備	標準装備	標準装備
異常表示	標準装備	標準装備	標準装備
インターロック機能	標準装備	標準装備	標準装備
自動成長システム (シャッター)	オプション	オプション	オプション
自動成長システム (温度)	オプション	オプション	オプション
残留ガス分析計	オプション	オプション	オプション

高温真空ベーキング装置



特徴

さまざまな用途に応じた高温真空ベーキング装置の設計・製作が可能です。

仕様

- 最高加熱温度：1000°C仕様
1500°C仕様
2000°C仕様
- 到達圧力： $<1.33 \times 10^{-4}$ Pa (ターボ分子ポンプ仕様)